科学研究費助成事業

平成 30 年 6月 15日現在

研究成果報告書

機関番号: 13901 研究種目: 基盤研究(B)(一般) 研究期間: 2015~2017 課題番号: 15H03876 研究課題名(和文)半導体ナノフォトダイオード粒子による高効率光エネルギー変換 研究課題名(英文)Efficient light energy conversion with semiconductor nano-photodiode particles

研究代表者

鳥本 司 (Torimoto, Tsukasa)

名古屋大学・工学研究科・教授

研究者番号:60271029

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 13,500,000円

研究成果の概要(和文):半導体ナノ粒子を用いる光エネルギー変換が注目されている。本研究では、低毒性元 素からなる多元半導体ナノ粒子を液相化学合成し、光エネルギー変換特性を評価した。ZnS-AgInS2固溶体(ZAIS) ナノ粒子の光触媒活性は、組成、サイズ、形状によって大きく変化した。特に、ロッド形状ZAIS粒子の両末端に 楕円球状ZAIS結晶を成長させたダンベル形状粒子は、Type II型ヘテロ接合を粒子内部にもつために効率良く光 電荷分離し、高い光触媒活性を示した。さらに、ZnTe-AgIgTe2固溶体(ZAITe)ナノ粒子薄膜電極では、表面に In2S3シェル層を析出させてヘテロ接合を形成すると大幅に光電流が向上した。

研究成果の概要(英文):Light energy conversion systems using semiconductor nanoparticles have been attracted much attention. In this study, we synthesized multinary semiconductor nanoparticles of low toxicity with solution phase methods and investigated their activities for light energy conversion. The photocatalytic activity of the ZnS-AgInS2 solid solution (ZAIS) nanoparticles was remarkably varied, depending on their particle composition, size, and shape. In particular, dumbbell-shaped ZAIS particles, composed of two ellipsoidal nanocrystals deposited on a rod-shaped particle, showed higher photocatalytic activity than those of single-component counterparts, due to the efficient charge separation at Type II heterojunction inside a particle. Furthermore, thin film photoelectrodes, composed of in the ZnTe-AgIgTe2 solid solution (ZAITe) nanoparticles, exhibited higher activity for photocurrent generation when the heterojunction was formed by the deposition of In2S3 shell layer on the ZAITe film surface.

研究分野: 電気化学

キーワード: 量子ドット 低毒性半導体 半導体ナノ粒子 ヘテロ接合 光触媒 太陽電池 カルコパイライト 多 元半導体

2版

1. 研究開始当初の背景

現在のエネルギー問題を解決できる有力 な方法の1つが、太陽エネルギーの高効率利 用である。光エネルギーを電気エネルギーと して利用するために、現在、Si 太陽電池が実 用化されているが、より高効率な光エネルギ 一変換システムの開発を目指して、太陽電池、 光触媒など新規デバイスの開発が、国内外で 活発に行われている。中でも、約 10nm 以下 の半導体ナノ粒子(量子ドット)を光吸収層 として用いる光エネルギー変換システムが 注目されている。これは、量子サイズ効果を 示す半導体ナノ粒子は、そのサイズ制御によ って光吸収特性を自在に制御可能なこと、さ らに、エネルギーの大きな光子1つを吸収し て複数の電子-正孔対を生成する(マルチエ キシトン生成)効率がバルク結晶に比べて非 常に大きいことによる。

量子ドットの多くは液相化学合成法によ り作製することができ、そのサイズおよび形 状は合成条件により変化する。さらに、化学 合成した量子ドットは、MOCVD などの物理 的な手法により作製したものと比較して粒 径分布が非常に狭く、エネルギーギャップ (Eg)がより均一なナノ粒子である。この特徴 は、光エネルギー変換デバイスの光吸収層と して用いるために最適な物性である。現在ま で、PbS や CdSe などの二元半導体ナノ粒子 を液相合成し、これを酸化チタンなどの多孔 質酸化物半導体電極に固定して量子ドット 太陽電池を作製する研究が数多く報告され てきた。しかし、その光エネルギー変換効率 は約5%程度とまだまだ低い。この原因は、 量子ドットからの電荷キャリアの効果的な 取り出しが困難となっているためである。ま た、現在の二元ナノ粒子の多くは、Cd や Pb など、高毒性元素を含むために、高い光エネ ルギー変換効率を示すデバイスを作製して も、使用範囲は極めて限られたものとなる。 - 方、私たちのグループでは、低毒性元素 からなる新規多元量子ドットとして ZnS-AgInS2 固溶体(ZAIS)ナノ粒子の開発に成 功した。この粒子では、Eg が粒子サイズある いは粒子組成を変化させるによって制御で きる特徴をもつ。ZAIS 粒子は結晶中に再結 合中心となる結晶欠陥が少なく非常に効率 よく発光する。また、私たちの研究グループ において、ZAIS ナノ粒子を用いる量子ドッ ト太陽電池を作製することに成功し、そのエ ネルギー変換効率は CdSe など従来のナノ粒 子を用いる量子ドット太陽電池に匹敵する

2. 研究の目的

ものであった。

本研究では、半導体ナノ粒子中に生成した 光励起電子と正孔の電荷分離を高効率で行 うために、1つの半導体ナノ粒子をそれとは 異なるエネルギー構造をもつ他の半導体ナ ノ粒子と接合させ、その接合界面に Type II 型のヘテロ接合をもつ新規半導体ナノ粒子 およびナノ粒子集合体の作製を目指す(ナノ フォトダイオード)。さらに、ヘテロ接合に より形成される電場勾配を利用して、半導体 ナノ粒子中に光生成した電荷キャリアの分 離を効率良く達成し、光エネルギー変換デバ イスの高効率化を目指す。

3.研究の方法

<u>3 - 1</u> 可視光領域に光吸収をもつ <u>ZnS-AgInS</u>2固溶体ナノ粒子の光学特性制御

可視光領域に強い光吸収をもつ ZnS-AgInS2固溶体(((AgIn)_xZn_{2(1-x}S₂, ZAIS)) ナノ粒子は、金属前駆体である酢酸銀、酢酸 インジウム、酢酸亜鉛と、硫黄前駆体である チオ尿素を、少量のドデカンチオール(DDT) を配位子として含むオレイルアミン(OLA)に 添加し、250℃で熱分解して合成した。得ら れた球状ナノ粒子の粒子組成は、前駆体の金 属元素の割合(Ag:In:Zn=x:x:2(1-x))を変化さ せることで制御した。また、DDT 添加量を増 加させることで、得られる ZAIS 粒子サイズ を小さくした。

<u>3-2</u> ZAIS ナノ粒子の粒子形状異方性制 御と粒子内部でのヘテロ接合形成

球状粒子の合成法を改良することで2種 類の形状異方性をもつ ZAIS ナノ粒子を液相 合成した。対応する金属酢酸塩と硫黄源(硫 黄と 1,3-ジブチルチオ尿素の混合物)を OLA-DDT の混合溶媒中に溶解させ、2段階 の反応温度(150℃で30分間、つづいて250℃ で3~10分間)で反応させることで作製した。 生成した ZAIS 粒子は、ロッド形状およびラ イス形状をもつ粒子の混合物であった。この 粒子混合物にサイズ選択的沈殿法を適用し、 形状ごとに ZAIS 粒子を単離し精製した。

単一粒子内部でのヘテロ接合形成は、ロッド形状 ZAIS ナノ粒子を核として、その末端に組成の異なる楕円球状 ZAIS 結晶を液相成長させることにより作製した。得られた ZAIS 粒子はダンベル形状を持っていた。

<u>3-3</u>水素発生反応に対する ZAIS ナノ粒 子の光触媒活性評価

正孔捕捉剤として Na₂S を含む水—2-プロ パノール混合溶液(1:1)に、各種の ZAIS ナノ粒子を分散させ、Xe ランプ光照射(λ> 350 nm)により発生する水素量を定量し、光 触媒活性を評価した。

<u>3-4</u> ZAITe ナノ粒子の合成と量子ドット <u>光電極の作製</u>

近赤外光領域に強い吸収をもつ ZnS-AgInTe2 固溶体(((AgIn)_xZn_{2(1-x})Te₂, ZAITe))ナノ粒子の合成は、対応する金属酢 酸塩とトリオクチルホスフィンに溶解させ たテルルを 1-ドデカンチオールに加え、180 ~300°Cで180分間加熱して作製した。得ら れた粒子はロッド形状をもち、単離・精製し たのちオクタンに溶解させて実験に用いた。 ZAITe ナノ粒子の固溶体組成は、前駆体中の 金属元素の仕込み割合(Ag:In:Zn=x:x:2(1-x)) を変化させることで制御した。

ZAITe ナノ粒子を 1-ヘキサンチールに分散 させ、ITO 基板上にスピンコートし、窒素雰 囲気下 350 ℃で加熱することで、ナノ粒子を 基板に固定させた。この操作を任意の回数繰 り返し、所望の膜厚の ZAITe 薄膜を作製した。 得られた ZAITe 薄膜を作用極として 0.2 mol dm³の Eu(NO₃)₃水溶液に浸漬し、Pt を対極、 Ag/AgCl 電極を参照極として三極セルを組ん だ。ZAITe 薄膜電極に Xe ランプ光 (λ > 350 nm) 照射を照射し、光電気化学特性を評価し た。また、化学浴析出法を用いて ZAITe 薄膜 表面に In₂S₃シェル層を析出させ、ヘテロ接合 界面が ZAITe 薄膜電極の光電気化学特性に及 ぼす影響を評価した。

4. 研究成果

<u>4-1</u> 球状 ZAIS ナノ粒子のサイズと組成 が光学特性に及ぼす影響

球状 ZAIS ナノ粒子は六方晶の結晶構造を 持ち、DDT 添加量を増加させることで、粒子 組成を変化させることなく、粒子サイズを8.5 nmから3.9 nmへと減少させることができた。 粒子組成は、前駆体中の金属元素の仕込み比 x を変化させるとことで制御でき、x の減少 によって粒子中のZn²⁺含有量がほぼ比例して 増加した。多元半導体ナノ粒子の特徴は、粒 子サイズの減少による Eg の増大に加えて、 粒子組成によっても Eg が大きく変化するこ とである(二元パラメータによる Eg 制御)。 例えば、ZAIS 粒子(組成 x=0.5)の吸収スペ クトルでは、粒子サイズが 8.5 nm から 3.9 nm へと減少すると、吸収端波長が約 650 nm か ら 500 nm に短波長シフトし、量子サイズ効 果による Eg の増大が確認できた。一方、粒 子サイズを 5.5 nm と一定にし、粒子組成 x を 1.0 から 0.1 に減少させて Zn 含有率を増加さ せると Eg が増大し、吸収端波長が約 680 nm から 450 nm に短波長シフトした。ZAIS 粒子 は、化学量論組成に近い組成をもつにもかか わらずバンド端発光を示さず、ドナー・アク セプター対再結合発光に帰属できるブロー ドな発光ピーク(半値幅 > 100 nm)のみを示 した。このことは、鋭いバンド端発光を示す Cd 系二元半導体ナノ粒子と大きく異なる。最 大の発光量子収率は、サイズが 5.7 nm で組成 x=0.5の ZAIS 粒子で得られ、79%と非常に高 い値であった。

<u>4-2 異方性形状をもつ ZAIS ナノ粒子の</u> 液相合成と粒子内部のヘテロ接合形成

半導体ナノ粒子の物理化学特性は、粒子形 状によっても変化する。従って、粒子組成と サイズの制御とともに、粒子形状の制御法を 開発することは非常に重要な課題である。私たちは、1段階加熱による球状 ZAIS 粒子の合成法を改良し、異なる温度による2段階加熱によって前駆体を熱分解させると、ロッド形状およびライス形状をもつ ZAIS 粒子が作製できることを見出した。150℃での1段階目の加熱により生成した球状 Ag2S 粒子が、2段階目の加熱(250℃)で析出する ZAIS 結晶の成長核となり、ロッド形状 ZAIS 粒子が生成した。さらに 250℃での加熱を続けると、均一核生成によって新たにライス形状 ZAIS 粒子が副生した。これらの粒子はサイズ選択的沈殿法によって分離した。

純粋なロッド形状 ZAIS 粒子(サイズ:約 4.6×27 nm)およびライス形状粒子(サイズ:約 9×16 nm)がそれぞれ単離された。ロッド 形状粒子の組成は、反応時の金属前駆体の仕 込み比によって制御できたが、ライス形状粒 子は得られる粒子組成にほとんど変化無か った。このため、単離したライス形状粒子に 新たに Zn²⁺ドーピングを行い、種々の固溶体 組成をもつライス形状 ZAIS 粒子を得た。

粒子内部にヘテロ接合をもつ ZAIS 粒子は、 ロッド形状 ZAIS 粒子を核として、その末端 に異なる組成の ZAIS 粒子を成長させること で作製した。図1aの TEM 観察より生成した 粒子は、ロッド粒子(幅 ca. 4 nm × 長さ 16~23 nm)の両末端に楕円球状 ZAIS 結晶(幅 ca. 4~6 nm × 長さ 7~11 nm)が成長したダン ベル形状をもつことがわかった。



図1 合成したダンベル形状 ZAIS 粒子の 低倍率 TEM 像(a) および高分解能 HAADF-STEM像(b)。組成(ロッド部分/ 楕円球部分): x=0.24/0.92。

ZAIS 固溶体組成を組成分析により求める と楕円球部分の組成 x は、ZAIS ロッド部分 の値(x=0.24)よりも大きくZn²⁺含有率が低いことがわかった。前駆体の仕込み比を変化させることで、末端部分の組成を x= 0.92~0.39の間で自在に制御することができた。ダンベル形状 ZAIS 粒子の高倍率HAADF-STEM像を図1bに示す。ロッド部分に末端楕円球部分がエピタキシャル成長したことがわかる。さらにその接合界面には、結晶格子のミスマッチが全くないことからキャリアのトラップサイトとなる結晶欠陥が存在しないと予想できる。

<u>4-3</u>水素発生反応に対する ZAIS ナノ粒 子の光触媒活性

人工光合成システムとして注目されてい る光エネルギーによる水素発生反応をモデ ル光触媒反応として用いた。

いずれの粒子サイズおよび組成の球状 ZAIS 粒子を用いても、光照射時間の増加と ともに水素発生量はほぼ直線的に増加した ことから、光触媒として ZAIS ナノ粒子が効 果的に働いていることがわかった。水素発生 量の時間変化の傾きから水素発生速度 (R(H₂))を求め、粒子サイズと組成に対する依 存性を評価した。同じ粒子サイズで比較する と、粒子組成 x=0.4 あるいは 0.5 の時に、R(H₂) が最も大きくなった。一方、同じ組成で比較 した場合では、ZAIS 組成にかかわらず、約5 nmまでは粒子サイズが小さくなるほどR(H₂) が増大したが、さらに粒子サイズが小さくな ると逆に低下した。このことは、電子エネル ギー構造の変化から説明できる。量子サイズ 効果により、ZAIS 粒子の伝導帯下端の電位 (E_{CB})は粒径減少とともにより負電位側に シフトし、光励起電子の還元力が増大するた めに H⁺還元反応速度が増大する。しかし、粒 子サイズがある値(約5nm)よりもさらに小 さくなると粒子表面でのキャリア再結合サ イトが顕著に増加し、光触媒反応に利用でき るキャリア濃度が減少する。これらの因子の バランスが最適な ZAIS 粒子のサイズと組成 を決めたと考えられる。

ナノ粒子の形状によっても、光触媒活性は、 大きく変化した。光触媒として、球状 ZAIS 粒子(サイズ:約5.5 nm)に加えて、異方性 形状を持つロッド形状 ZAIS 粒子(サイズ: 約 4.6×27 nm) とライス形状 ZAIS 粒子 (サイ ズ:約9×16 nm)を用い、その水素発生反応 に対する光触媒活性を求めた。粒子形状が球 状およびライス形状の場合には、ZAIS 粒子 の光触媒活性は Eg に対して火山型の依存性 を示し、形状によらずほぼ同じ組成(球状: x=0.40、ライス形状: x=0.45) で最も R(H₂) が大きくなった。一方、ロッド形状粒子を用 いた場合では、組成 x が増加するにつれて R(H2)が単調に増大し、x=0.35のとき最大値を 示した。これらは粒子組成の変化による EcB の負電位シフトと Eg の増大による吸収光子 数の減少から説明できた。また、水素発生反 応に対する量子効率を 400 nm 単色光照射に

より求めたところ、その値はライス形状: 2.0%、球状:2.6%、ロッド形状:5.9%の順で 大きくなった。粒子中の光生成キャリアの寿 命の違いが、これらの光触媒活性の差に関係 しており、ロッド形状 ZAIS 粒子中の光生成 キャリアの寿命は 1150 ns であり、球状粒子 における光生成キャリアの寿命 602 ns よりも 十分に長いものであった。より長寿命の光励 起電子がロッド形状 ZAIS 粒子中に存在する ので溶液中の H⁺との反応確率がより増加し、 光触媒活性が増大したと考えられる。

ある半導体を異なる半導体と接合させて ヘテロ接合を形成させると、粒子中に光生成 したキャリアのダイナミクスが大きく変調 される。とくに、一方の半導体の伝導帯下端 (E_{CB})および価電子帯上端(E_{VB})が他方の 半導体よりもともに負電位側(あるいは正電 位側)にずれた電子構造を、Type II型ヘテロ 接合という。このヘテロ接合が形成させると、 光生成した電子と正孔が空間的に効率良く 分離され、長寿命な光キャリアを生成させる ことができる。ZAIS 粒子の電子エネルギー 構造は前述のように組成に依存して変化す ることから、粒子内部で空間的に組成を変調 することができれば、粒子内部に容易にヘテ ロ接合が形成されると期待できる。

ダンベル形状 ZAIS 粒子において末端楕円 球部分とロッド部分ではZn²⁺含有率が異なる ことから、ロッド部分/楕円球部分の接合界 面でヘテロ接合が形成される。大気中光電子 分光測定により、ダンベル形状 ZAIS 粒子の 電子エネルギー構造を求めたところ、Zn²⁺含 有率のより小さい末端楕円球 ZAIS 部分で E_{CB} がより正電位側にシフトしており、ロッ ド部分/楕円球部分の接合界面で Type II 型 ヘテロ接合が形成されていることがわかっ た。そこで、ダンベル形状 ZAIS 粒子を光触 媒として水素発生反応を行い、ロッド形状あ るいは楕円球形状をもつ単一粒子の活性と 比較した。

ダンベル形状 ZAIS 粒子(組成(ロッド部 分/楕円球部分):x=0.24/0.39)の水素発生速 度は、ロッド形状 ZAIS 粒子(x=0.24)や楕円球 形状 ZAIS 粒子(x=0.39)のものよりも大きか った。これは、ダンベル形状粒子内部の Type II ヘテロ構造によって光生成キャリアの再結 合が抑制され、光触媒反応に利用可能な電子 数が増加したためである。このことは、発光 寿命測定からも確認された。

<u>4-4</u> ZAITe ナノ粒子を光増感層とする量 子ドット光電極の作製と光エネルギー変換 特性の向上

ZAITe ナノ粒子は、固溶体組成 x の値によ らずサイズがほぼ一定であり、16×4 nm のロ ッド形状であった。ナノ粒子の吸収スペクト ルは、粒子中の Zn²⁺含有率の増加とともに短 波長側にシフトし、吸収端波長から求めた Eg は 1.2 eV から 1.6 eV へと増加した。いずれの ZAITe 粒子もバンド端発光を示し、発光ピー ク波長はEgの増加とともに1010 nmから809 nm へと短波長シフトした。

ZAITe ナノ粒子を ITO 上に塗布して加熱す ることで、膜厚約 200 nm の緻密な半導体ナ ノ粒子薄膜を得た。ZAITe ナノ粒子薄膜の吸 収スペクトルの立ち上がり波長は、x の値に よらず、前駆体として用いた ZAITe ナノ粒子 よりも約 50 nm 長波長シフトした。これは、 薄膜作製時の加熱によってZAITe 粒子の結晶 子径が増大し、量子サイズ効果が消失したた めである。

電子捕捉剤として Eu(NO3)3 を含む溶液に ZAITe 薄膜を浸漬して断続的に光照射すると、 薄膜の組成によらずカソード光電流が得ら れ、p 型半導体に類似した光応答を示した。 カソード光電流の作用スペクトルの立ち上 がり波長は、ZAITe ナノ粒子薄膜の吸収スペ クトルの吸収端とよく一致した。このことか ら、ZAITe ナノ粒子の固溶体組成比を変化さ せることで、得られる半導体ナノ粒子薄膜の 光応答波長を近赤外光から可視光までの広 い波長範囲で制御可能であることがわかっ た。さらに、n型In₂S₃半導体シェル層をZAITe ナノ粒子薄膜(p型半導体)上に析出させ、 薄膜表面に Type Ⅱ 型のヘテロ接合界面を形 成させた。得られた ZAITe/In₂S₃ 半導体薄膜は、 ZAITe 薄膜のみの場合よりも大きな光応答を 示した。また、Type II 型ヘテロ接合形成によ る光電流増大効果は、組成 x が大きい、すな わち、Zn²⁺含有率の小さい ZAITe 薄膜でより 顕著となった。

4-5. 結論

本研究では、低毒性元素からなる新規 Ag 系 多元半導体ナノ粒子を高精度に液相化学合 成することに成功し、その物理化学特性を粒 子組成とサイズ、形状によって制御可能であ ることを見出した。さらに、これら多元ナノ 粒子を光触媒や光電極に利用したところ、高 い光エネルギー変換効率を得るためには、最 適なナノ粒子の組成、サイズ、形状が存在す ることを明らかにした。また、異なる組成の 半導体ナノ結晶を多元半導体ナノ粒子表面 に析出させることで、粒子内部に Type II 型へ テロ接合を形成させることに成功した。ナノ フォトダイオードとも見なせるこれらのへ テロ接合ナノ粒子では、光励起電子・正孔対 の電荷分離が空間的に効率良く起こり、ナノ 粒子の光触媒活性や光電変換効率が大きく 向上することを明らかにした。今後は、様々 な種類の多元半導体ナノ粒子を用いてヘテ ロ接合ナノ粒子を作製し、その電子エネルギ ー構造をさらに高精度に制御することで、実 用化可能な光エネルギー変換デバイスの開 発が可能になると期待される。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計 14件) (1) <u>T. Kameyama</u>, S. Koyama, T. Yamamoto, S.

Kuwabata, and T. Torimoto, "Enhanced Photocatalytic Activity of Zn-Ag-In-S Semiconductor with Nanocrystals а Dumbbell-Shaped Heterostructure", J. Phys. Chem. С, 2018, in press. DOI :10.1021/acs.jpcc.8b00255 (査読有)

(2) <u>T. Kameyama</u>, K. Sugiura, Y. Ishigami, T. Yamamoto, S. Kuwabata, T. Okuhata, N. Tamai, and <u>T. Torimoto</u>, "Rod-Shaped Zn-Ag-In-Te Nanocrystals with Wavelength-Tunable Band-Edge Photoluminescence in the Near-IR Region", *J. Mater. Chem. C*, **2018**, *6*, 2034-2042. DOI: 10.1039/C7TC05624A(査読有)

(3) T. Hamada, D. Sugioka, <u>T. Kameyama</u>, S. Kuwabata, and <u>T. Torimoto</u>, "Electrocatalytic Activity of Bimetallic Pd-Au Particle Films Prepared by Sequential Sputter Deposition of Pd and Au onto Hydroxyl-functionalized Ionic Liquid", *Chem. Lett.*, **2017**, *46*, 956-959. DOI: 10.1246/cl.170242 (査読有)

(4) <u>T. Kameyama</u>, Y. Ishigami, H. Yukawa, T. Shimada, Y. Baba, T. Ishikawa, S. Kuwabata, and <u>T. Torimoto</u>, "Crystal Phase-controlled Synthesis of Rod-shaped AgInTe₂ Nanocrystals for in vivo Imaging in the Near-infrared Wavelength Region", *Nanoscale*, **2016**, *8*, 5435-5440. DOI: 10.1039/C5NR07532G(査読有)

(5) D. Sugioka, <u>T. Kameyama</u>, S. Kuwabata, T. Yamamoto, and <u>T. Torimoto</u>, "Formation of a Pt-Decorated Au Nanoparticle Monolayer Floating on an Ionic Liquid by the Ionic Liquid/Metal Sputtering Method and Tunable Electrocatalytic Activities of the Resulting Monolayer", *ACS Appl. Mater. Interface*, **2016**, *8*, 10874-10883. DOI: 10.1021/acsami.6b01978 (查 読有)

(6) D. K. Sharma, S. Hirata, L. Bujak, V. Biju, <u>T.</u> <u>Kameyama</u>, M. Kishi, <u>T. Torimoto</u> and M. Vacha, "Single-particle Spectroscopy of I-III-VI Semiconductor Nanocrystals: Spectral Diffusion and Suppression of Blinking by Two-color Excitation", *Nanoscale*, **2016**, *8*, 13687-13694. DOI: 10.1039/C6NR03950B(査読有)

(7) <u>T. Torimoto</u>, Y. Kamiya, <u>T. Kameyama</u>, H. Nishi, T. Uematsu, S. Kuwabata, and T. Shibayama, "Controlling Shape Anisotropy of ZnS-AgInS₂ Solid Solution Nanoparticles for Improving Photocatalytic Activity", *ACS Appl. Mater. Interfaces*, **2016**, *8*, 27151-27161. DOI: 10.1021/acsami.6b10408(査読有)

(8) D. Sugioka, <u>T. Kameyama</u>, S. Kuwabata, and <u>T. Torimoto</u>, "Single-step Preparation of Two-dimensionally Organized Gold Particles via Ionic Liquid/Metal Sputter Deposition", *Phys. Chem. Chem. Phys.*, **2015**, *17*, 13150-13159. DOI: 10.1039/C5CP01602A (査読有)

(9) <u>T. Kameyama</u>, T. Takahashi, T. Machida, Y. Kamiya, T. Yamamoto, S. Kuwabata, and <u>T. Torimoto</u>, "Controlling the Electronic Energy Structure of ZnS-AgInS₂ Solid Solution

Nanocrystals for Photoluminescence and Photocatalytic Hydrogen Evolution", J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 24740-24749. DOI: 10.1021/acs.jpcc.5b07994 (査読有)

〔学会発表〕(計 13件)

(1) <u>T. Torimoto</u>, Y. Kamiya, S. Kuwabata and, <u>T. Kameyama</u>, "Enhancement of Photocatalytic H₂ Evolution Activity of ZnS-AgInS₂ Solid Solution Nanocrystals by Controlling Their Shape Anisotropy", *231st ECS Meeting*, San Diego, 2017.

(2) <u>T. Torimoto</u>, Y. Kamiya, S. Kuwabata, and <u>T. Kameyama</u>, "Shape-Dependent Photocatalytic H₂ Evolution Activity of ZnS-AgInS₂ Solid Solution Nanoparticles", *PRiMe*, Honolulu, 2016.

(3) <u>T. Torimoto</u>, Y. Douke, H. Shibakawa, S. Kuwabata, and <u>T. Kameyama</u>, "Tunable Electronic Energy Structure of ZnSe-AgInSe₂ Solid Solution Nanoparticles for Solar Energy Conversion", *227th ECS Meeting*, Chicago, 2015.

〔図書〕(計 3件)

(1) <u>鳥本</u>司,<u>亀山達矢</u>,桑畑進,"低毒性 元素からなる多元金属カルコゲニド半導体 ナノ粒子の合成と光機能",福田武司監修, *量子ドット・マイクロ LED ディスプレイおよ び関連材料の技術開発、シーエムシー・リサ* ーチ、13-32 (2017). ISBN: 978-4-904482-44-5 (2) <u>鳥本</u>司,杉岡大輔,<u>亀山達矢</u>,吉井一 記,桑畑進,"高性能電極触媒の開発を目 指したイオン液体/金属スパッタリングに よる金属ナノ粒子合成",渡邉正義 監修,*イ オン液体研究最前線と社会実装、シーエムシ* ー 出版, 207-219 (2016). ISBN: 978-4-7813-1227-9

(3) <u>T. Torimoto, T. Kameyama</u>, and S. Kuwabata, "Top-Down Synthesis Methods for Nanoscale Catalysts", M. H. G. Prechtl ed., *Nanocatalysis in Ionic Liquids*, Wiley, Weinheim, Ch.9, 171-205 (2016). ISBN: 978-3-527-33910-5

〔産業財産権〕

o出願状況	(計	0件)
-------	----	-----

○取得状況(計 0件)

〔その他〕

ホームページ

http://www.apchem.nagoya-u.ac.jp/06-K-6/torim oto/index_eng.html

アウトリーチ活動

「週末ワークショップ」をトヨタ産業技術記 念館(名古屋)で開催し、小・中学生向け授 業と実習を行った。参加人数:小中学生:20 名。2015~2017年の夏に毎年開催した。 6. 研究組織

(1)研究代表者
鳥本 司 (TORIMOTO,Tsukasa)
名古屋大学・大学院工学研究科・教授
研究者番号: 60271029

(2)研究分担者
亀山達矢(KAMEYAMA,Tatsuya)
名古屋大学・大学院工学研究科・助教
研究者番号:40646759